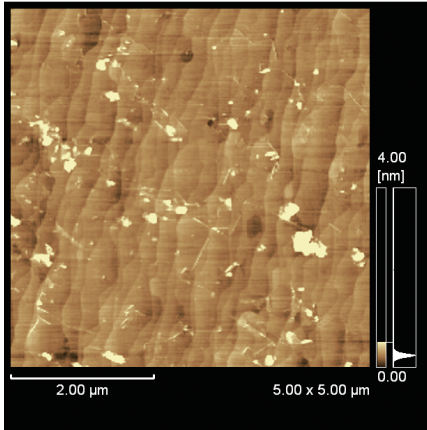


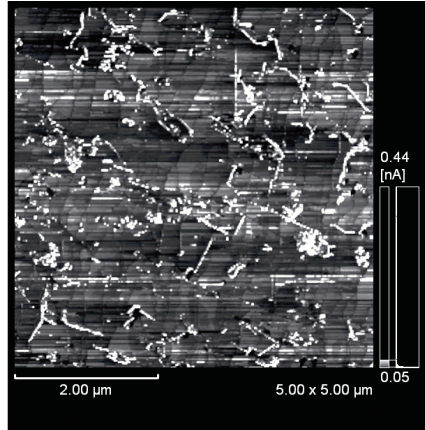
SiC上にエピタキシャル成長させた数層グラフェンのSPMによる電流測定とKFM測定

Conductance and KFM measurements of few-layer graphene epitaxially grown on SiC substrate by using SPM

電流測定 / Conductance measurement

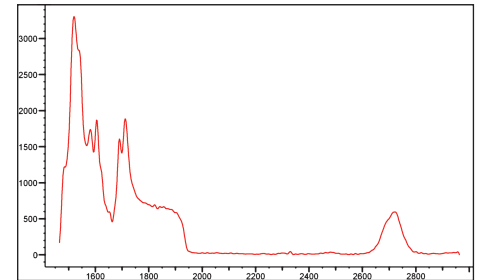


形状像



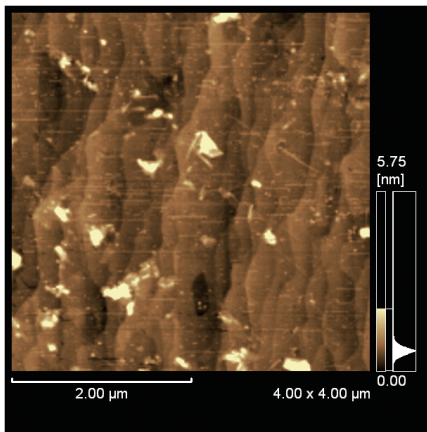
電流像

ラマン測定結果

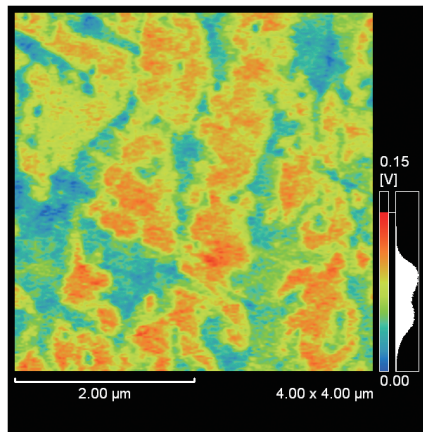


電流像でグラファイトのステップテラス構造に対応した電流が認められます。
測定条件：0.1 Pa以下で12時間真空引き後、探針の加重約100nNにて測定しました。

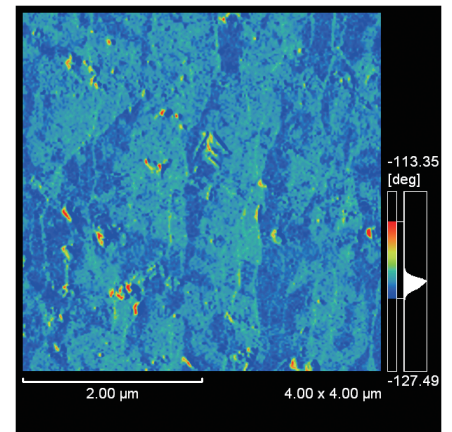
KFM測定 / KFM measurement



形状像



KFM像



位相像

位相分布に沿ったKFM分布が得られています。
測定条件：乾燥窒素ガス中にて、同一場所でKFMと位相像を取得しました。

参考文献：M. Nagasø et al., *Nanotechnology*, 20, 445704 (2009).
試料ご提供：徳島大学 大学院 (The University of Tokushima) ソシオテクノサイエンス研究部
永瀬雅夫先生 (Masao NAGASE, Dr. Eng.)